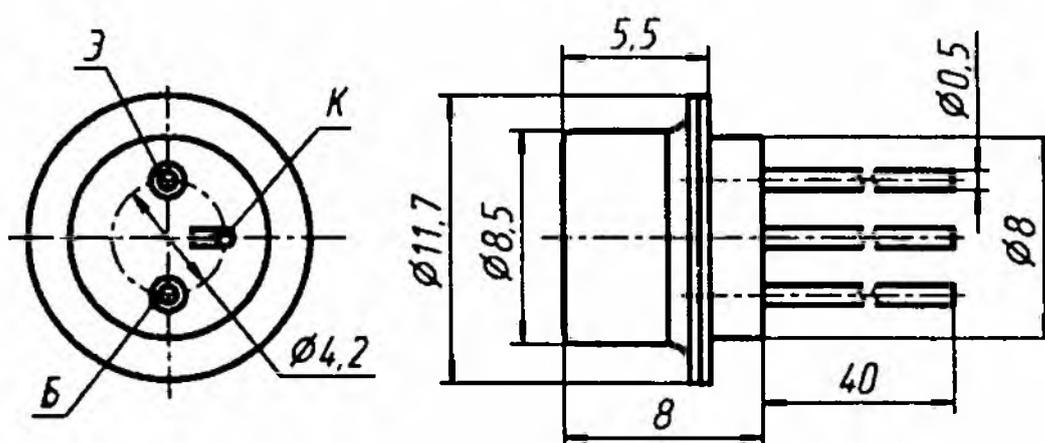


КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ

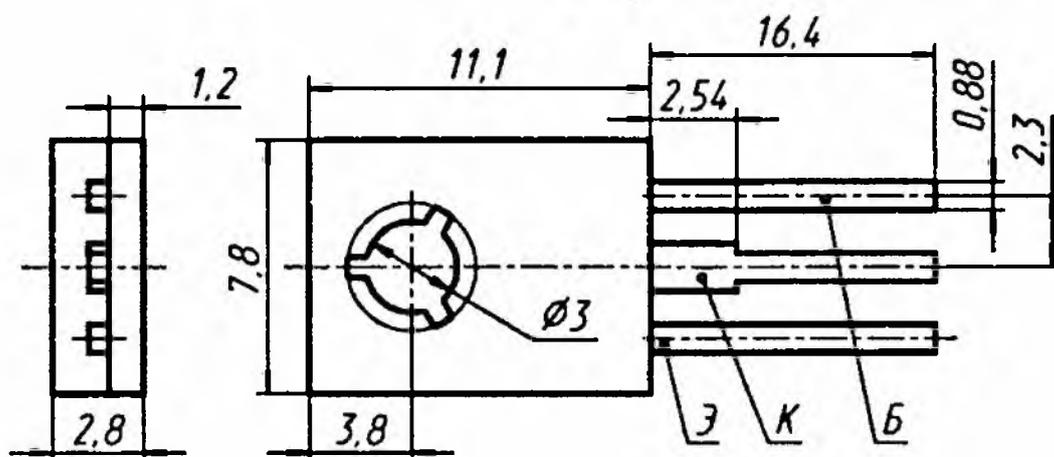
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n*. Предназначены для применения в усилителях, импульсных и переключающих высокочастотных устройствах. Выпускаются в металlostеклянном (КТ605А, КТ605Б) с гибкими выводами и пластмассовом (КТ605АМ, КТ605БМ) корпусах с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металlostеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом — не более 1 г.

КТ605(А,Б)



КТ605(АМ,БМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока	
в схеме ОЭ при $I_3 = 20$ мА, $U_{КБ} = 40$ В:	
КТ605А, КТ605АМ	10...40
КТ605Б, КТ605БМ	30...120
Граничная частота коэффициента передачи	
тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 40$ В, $I_3 = 20$ мА,	
не менее	
	40 МГц
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	
при $I_К = 20$ мА, $I_Б = 2$ мА, не более	
	8 В
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{КБ} = 40$ В, $f = 2$ МГц, не более	
	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$,	
$f = 2$ МГц, не более	
	50 пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $U_{КЭ} = 250$ В, не более	
	20 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 5$ В,	
не более	
	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
при $T = +100$ °С	300 В
при $T = +150$ °С	150 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	
при $R_{БЭ} = 1$ кОм:	
при $T = +100$ °С	250 В
при $T = +150$ °С	125 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
при $T = +100$ °С	5 В
при $T = +150$ °С	2,5 В
Постоянный ток коллектора	
	100 мА
Импульсный ток коллектора	
	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
$T = +25$ °С	0,4 Вт
$T = +100$ °С	0,17 Вт
Тепловое сопротивление переход—среда	
	300 °С/Вт
Температура р-п перехода	
	+150 °С
Температура окружающей среды и корпуса	
	-40...+150 °С

Изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При установке транзистора на печатную плату с шагом координатной сетки 2,5 мм допускается одноразовая формовка выводов с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (контактами).

При изгибе и формовке выводов необходимо применять специальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом транзистора. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора в течение не более 5 с. Температура паяльника не должна превышать $+260^\circ\text{C}$. При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.